



Łukasiewicz

PORT
Polski Ośrodek
Rozwoju
Technologii

Wrocław, dnia 23-05-2024 r.
Nr Sprawy: PORT/WZ/2024/05/00068

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
ul. Stabłowicka 147,
54-066 Wrocław

Zaprasza Państwa do złożenia oferty na:

Pomiary rozkładu pól elektrycznych w heterostrukturach AlGaIn/GaN przy pomocy elektrodobicia

Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego – OPZ.

I. Zakres zamówienia oraz termin realizacji:

Wszystkie szczegóły zamówienia opisuje **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego – OPZ.

II. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne doświadczenie oraz wiedzę do realizacji niniejszego zamówienia.
2. Zamawiający **nie dopuszcza** do składania ofert częściowych.
3. Zostanie złożone zamówienie
4. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny lub kosztu.
5. Mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):

- Składając ofertę, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835).

III. Miejsce oraz termin składania ofert:



Projekt pn. „Wysokonapięciowe tranzystory GaN HEMT do zastosowań w zasilaczach liniowych i płytach indukcyjnych” finansowany ze środków Centrum Łukasiewicz na podstawie umowy nr 1/Ł-IMiF/CŁ/2023

Strona 1 z 3

Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, +48 71 734 77, biuro@port.lukasiewicz.gov.pl
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000850580, NIP: 894 314 05 23, REGON: 386585168

1. Oferta powinna być złożona na wzorze stanowiącym **Załącznik nr 2** oraz **Załącznik nr 1** do niniejszego zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: anna.kaszuba@port.lukasiewicz.gov.pl **do dnia 28.05.2024 r. włącznie**
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia oferty.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.

IV. Kryteria oceny ofert:

1. Cena 100 %

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena całkowita (C) waga 100 %, według wzoru:

$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{Cena minimalna}}{\text{Cena badana}} \times \text{waga (100)} = \dots\dots\dots \text{Punktów}$$

Maksymalna ilość zdobytych punktów: 100

Zdobyta ilość punktów = C

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania i zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru ofert, jak również jego unieważnienia bez podawania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie będą przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia finansowe w stosunku do Zamawiającego.

V. Cena oferty i warunki płatności:

1. Zamawiający wymaga określenia ceny przedmiotu zamówienia w PLN netto i brutto.
2. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną oraz zawierać koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
3. Termin płatności 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, na zasadach określonych w umowie.
4. Faktura może być wystawiona na podstawie podpisanego przez Zamawiającego „Protokołu serwisowego” z adnotacją „bez uwag” w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, wynikającego z pierwotnego zapytania ofertowego. Po upływie tego terminu, Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający udziela wyjaśnień przed upływem terminu składania ofert i zamieszcza je w miejscu publikacji.
2. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego, zamieszczając informację o zmianie w miejscu publikacji.
3. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może przedłużyć termin składania ofert w szczególności w przypadku zmiany treści zapytania lub załączników.



Projekt pn. „Wysokonapięciowe tranzystory GaN HEMT do zastosowań w zasilaczach liniowych i płytach indukcyjnych” finansowany ze środków Centrum Łukasiewicz na podstawie umowy nr 1/L-IMI/C/2023



4. W przypadku kiedy nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Negocjatom podlegać będzie cena jako jedyne kryterium wyboru. Zamawiający wyśle do Wykonawców Zaproszenie do negocjacji. Cena zaoferowana przez Wykonawców w czasie negocjacji, nie może być mniej korzystna niż zaoferowana w pierwotnej ofercie.
5. Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o:
 - wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - odrzuceniu oferty,
 - unieważnieniu postępowania.
6. Zamawiający opublikuje w miejscu publikacji informację, o wyborze najkorzystniejszej oferty lub o unieważnieniu postępowania.

VII. Wykaz załączników:

1. Opis przedmiotu zamówienia,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór Umowy
4. Klauzula Informacyjna Dot. Przetwarzania Danych Osobowych przez Łukasiewicz – Port

.....
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządziła: Anna Kaszuba



Projekt pn. „Wysokonapięciowe tranzystory GaN HEMT do zastosowań w zasilaczach liniowych i płytach indukcyjnych” finansowany ze środków Centrum Łukasiewicz na podstawie umowy nr 1/L-IMiF/CL/2023

